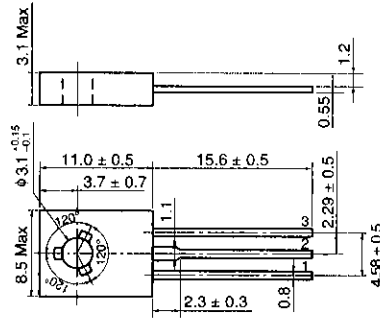


2SB649, 2SB649A

シリコン PNP エピタキシャル形
低周波電力増幅用
2SD669/Aとコンプリメンタリペア

SILICON PNP EPITAXIAL
LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
Complementary pair with 2SD669/A



1. エミッタ: Emitter
2. コレクタ: Collector
3. ベース: Base
(Dimensions in mm)

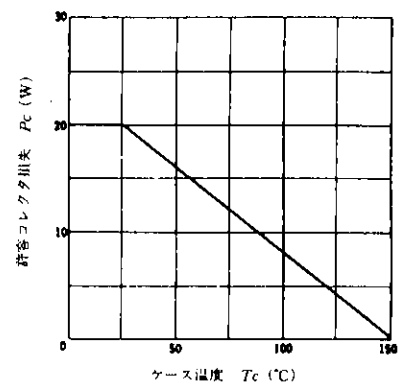
(JEDEC TO-126 MOD.)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SB649	2SB649A	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	-180	-180	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	-120	-160	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	-5	-5	V
コレクタ電流	I_C	-1.5	-1.5	A
せん頭コレクタ電流	$I_{C(\text{peak})}$	-3	-3	A
許容コレクタ損失	P_C	1	1	W
許容コレクタ損失	P_C^*	20	20	W
接合部温度	T_j	150	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値
* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION
CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	2SB649			2SB649A			Unit
			min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	
コレクタ・ベース破壊電圧	V_{BRICB0}	$I_C = -1\text{mA}, I_E = 0$	-180	-	-	-180	-	-	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	V_{BRICE0}	$I_C = -10\text{mA}, R_{BE} = \infty$	-120	-	-	-160	-	-	V
エミッタ・ベース破壊電圧	V_{BREB0}	$I_E = -1\text{mA}, I_C = 0$	-5	-	-	-5	-	-	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -160\text{V}, I_E = 0$	-	-	-10	-	-	-10	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -150\text{mA}$	60	-	320	60	-	200	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -500\text{mA}^{**}$	30	-	-	30	-	-	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C = -500\text{mA}, I_B = -50\text{mA}$	-	-	-1	-	-	-1	V
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -150\text{mA}$	-	-	-1.5	-	-	-1.5	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -150\text{mA}$	-	140	-	-	140	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$	-	27	-	-	27	-	pF

* 2SB649, 2SB649A は h_{FE1} の値により下記のように区分し、現品に表示しております。

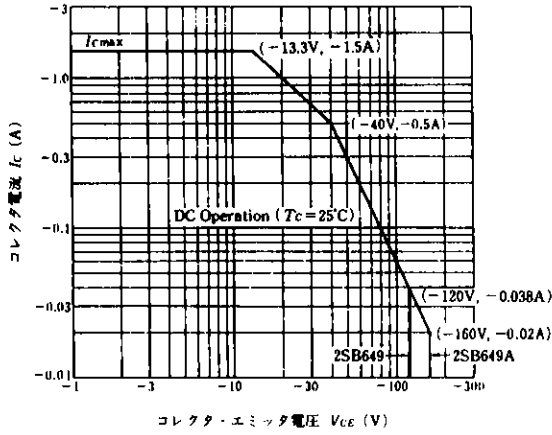
* The 2SB649 and 2SB649A are grouped by h_{FE1} as follows.

** ハルス測定

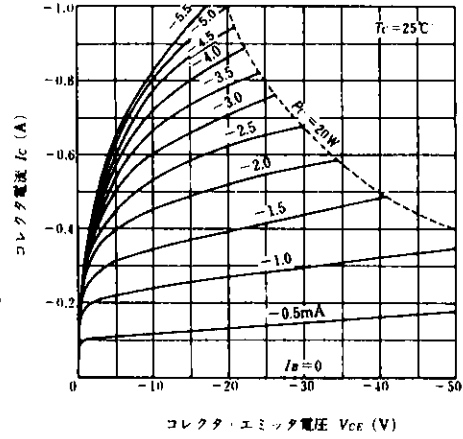
** Pulse Test

	B	C	D
2SB649	60~120	100~200	160~320
2SB649A	60~120	100~200	-

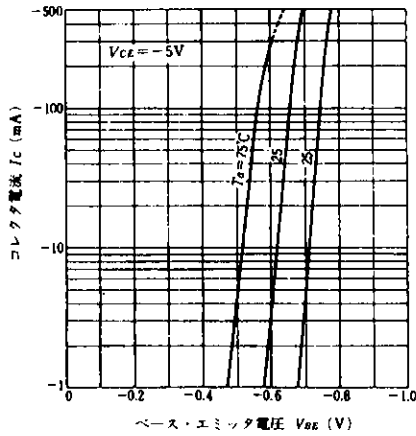
安全動作領域
AREA OF SAFE OPERATION



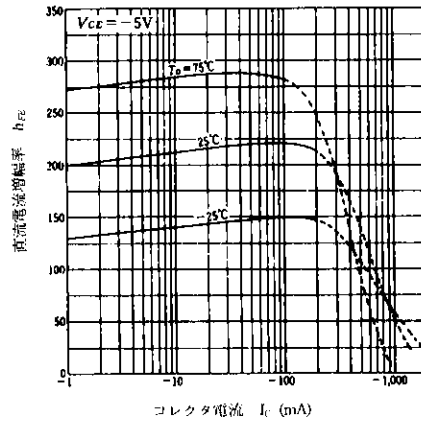
エミッタ接地出力特性
TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS



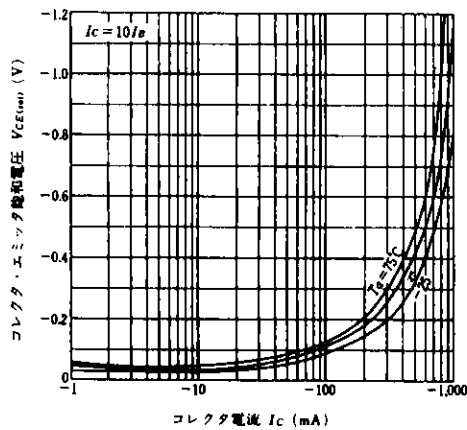
エミッタ接地伝達特性
TYPICAL TRANSFER CHARACTERISTICS



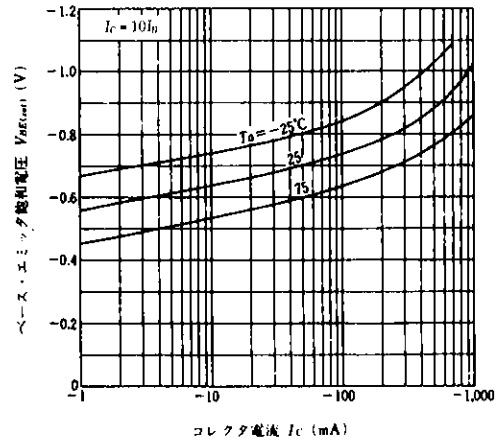
直流電流増幅率対コレクタ電流特性
DC CURRENT TRANSFER RATIO
VS. COLLECTOR CURRENT



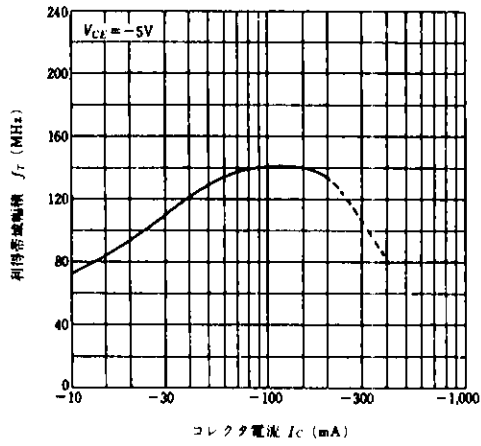
コレクタ・エミッタ飽和電圧対コレクタ電流特性
COLLECTOR TO EMITTER SATURATION
VOLTAGE VS. COLLECTOR CURRENT



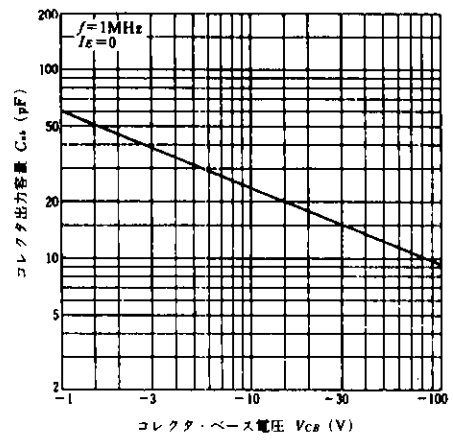
ベース・エミッタ飽和電圧対コレクタ電流特性
BASE TO EMITTER SATURATION VOLTAGE
VS. COLLECTOR CURRENT



利得帯域幅積対コレクタ電流特性
**GAIN BANDWIDTH PRODUCT
 VS. COLLECTOR CURRENT**



コレクタ出力容量対コレクタ・ベース電圧特性
**COLLECTOR OUTPUT CAPACITANCE VS.
 COLLECTOR TO BASE VOLTAGE**



注) 本データブック発行により、1996年発行のバイポーラパワートランジスタ (ADJ-408-005C) は廃棄のほどお願い申し上げます。

1. 本書に記載の製品及び技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に基づき安全保障貿易管理関連貨物・技術に該当するものを輸出する場合、または国外に持ち出す場合は日本国政府の許可が必要です。
2. 本書に記載された情報の使用に際して、弊社もしくは第三者の特許権、著作権、商標権、その他の知的所有権等の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。また本書に記載された情報を使用した事により第三者の知的所有権等の権利に関わる問題が生じた場合、弊社はその責を負いませんので予めご了承ください。
3. 製品及び製品仕様は予告無く変更する場合がありますので、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては、事前に最新の製品規格または仕様書をお求めになりご確認ください。
4. 弊社は品質・信頼性の向上に努めておりますが、宇宙、航空、原子力、燃焼制御、運輸、交通、各種安全装置、ライフサポート関連の医療機器等のように、特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途にご使用をお考えのお客様は、事前に弊社営業担当迄ご相談をお願い致します。
5. 設計に際しては、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件及びその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用いただきますようお願い致します。
保証値を越えてご使用された場合の故障及び事故につきましては、弊社はその責を負いません。
また保証値内のご使用であっても半導体製品について通常予測される故障発生率、故障モードをご考慮の上、弊社製品の動作が原因でご使用機器が人身事故、火災事故、その他の拡大損害を生じないようにフェールセーフ等のシステム上の対策を講じて頂きますようお願い致します。
6. 本製品は耐放射線設計をしておりません。
7. 本書の一部または全部を弊社の文書による承認なしに転載または複製することを堅くお断り致します。
8. 本書をはじめ弊社半導体についてのお問い合わせ、ご相談は弊社営業担当迄お願い致します。